

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

YAMADA

Application No.: 09/680,963

Filed: October 6, 2000



RECEIVED

DEC 28 2000

Group Art Unit: 2612

Examiner: Not yet assigned
Technology Center 2600

Attorney Dkt. No.: 107317-00017

For: CHARGE TRANSFER DEVICE, SOLID STATE IMAGE PICKUP DEVICE
USING CHARGE TRANSFER DEVICE, AND CONTROL METHOD FOR SOLID
STATE IMAGE PICKUP DEVICE

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 USC § 119

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

December 27, 2000

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign countries is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

**Japan Patent Application No. 11-287338 filed on July 10, 1999 in Japan; and
Japan Patent Appln. No. 2000-287486, filed on September 21, 2000 in Japan.**

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Please charge any fee deficiency or credit any overpayment with respect to this paper to Deposit Account No. 01-2300.

Respectfully submitted,

Douglas H. Goldhush
Registration No. 33,125

ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC

1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 600

Washington, D.C. 20036-5339

Tel: (202) 857-6000

Fax: (202) 638-4810

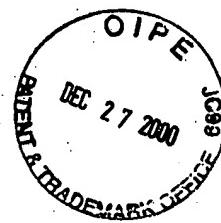
DHG:scc

Enclosure: Priority Documents (2)

K. H.

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

RECEIVED

出願年月日
Date of Application:

1999年10月 7日

DEC 28 2000

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第287338号

Technology Center 2600

出願人
Applicant(s):

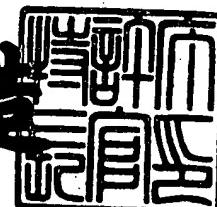
富士フィルムマイクロデバイス株式会社
富士写真フィルム株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 7月 21日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3056965

【書類名】 特許願
【整理番号】 DL2438
【提出日】 平成11年10月 7日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 27/14
【発明の名称】 電荷転送装置、それを用いた固体撮像装置及びその制御方法
【請求項の数】 11
【発明者】
【住所又は居所】 宮城県黒川郡大和町松坂平1丁目6番地 富士フィルム
マイクロデバイス株式会社内
【氏名】 山田 哲生
【特許出願人】
【識別番号】 391051588
【氏名又は名称】 富士フィルムマイクロデバイス株式会社
【代表者】 加藤 典彦
【特許出願人】
【識別番号】 000005201
【氏名又は名称】 富士写真フィルム株式会社
【代表者】 宗雪 雅幸
【代理人】
【識別番号】 100091340
【弁理士】
【氏名又は名称】 高橋 敬四郎
【電話番号】 03-3832-8095
【選任した代理人】
【識別番号】 100105887
【弁理士】
【氏名又は名称】 来山 幹雄

【電話番号】 03-3832-8095

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009852

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9502507

【包括委任状番号】 9804706

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電荷転送装置、それを用いた固体撮像装置及びその制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板と、

該半導体基板中に形成された第1導電型半導体層からなる電荷転送路と、

該電荷転送路上に近接して形成された複数の電荷転送電極と、

該電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn（nは2以上の整数）相駆動する第1のパルス信号列を印加できるとともに、前記電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn+1相以上で駆動する第2のパルス信号列を印加できる第1のパルス信号発生回路と
を含む電荷転送装置。

【請求項2】

半導体基板と、

該半導体基板中に形成された第1導電型半導体層からなる電荷転送路と、

該電荷転送路上に近接して形成された複数の電荷転送電極と、

該電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn（nは2以上の整数）相駆動する第1のパルス信号列を印加できるとともに、前記電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn×m（mは2以上の整数）相以上で駆動する第3のパルス信号列を印加できる第2のパルス信号発生回路と
を含む電荷転送装置。

【請求項3】

半導体基板と、

該半導体基板中に形成された第1導電型半導体層からなり、ポテンシャルの高い第1のバリア層とポテンシャルの低い第1のウェル層とが隣接して交互に配置された電荷転送路と、

該電荷転送路上の前記第1のバリア層と前記第1のウェル層との上に近接して交互に形成された複数の第1の電荷転送電極および第2の電荷転送電極と、

前記第1の電荷転送電極とそれと隣接する前記第2の電荷転送電極とを相互に

1つずつ接続して形成される複数の電荷転送電極対と、

前記電荷転送路中の電荷を2相駆動する2相の第4のパルス信号列を隣接する2つの前記電荷転送電極対に対して印加できるとともに、前記電荷転送電極対に対して前記電荷転送路中の電荷を $2k$ (k は2以上の整数) 相以上で駆動する第5のパルス信号列を印加できる第3のパルス信号発生回路とを含む電荷転送装置。

【請求項4】

さらに、前記電荷転送電極の最終段に隣接して形成され、前記電荷転送路内を転送された電荷を一時的に蓄積する電荷蓄積部と、

該電荷蓄積部に蓄積された電荷量を検出する電荷検出部とを含む請求項1から3までのいずれか1項に記載の電荷転送装置。

【請求項5】

前記電荷蓄積部は、

前記電荷転送路上において隣接して形成された第2のバリア層及び第2のウェル層と、

前記第2のバリア層と前記第2のウェル層との上に形成された第3の電荷転送電極および第4の電荷転送電極と、

前記第3の電荷転送電極及び前記第4の電荷転送電極と接続され、蓄積電荷放出用パルスを発生する蓄積電荷放出用パルス発生回路とを含む請求項4記載の電荷転送装置。

【請求項6】

前記第1のウェル層の電気容量よりも大きい電気容量を有する第2のウェル層と、

該第2のウェル層に隣接して設けられ、前記水平電荷転送路から転送された電荷の量を検出するフローティングディフュージョン領域とを含む請求項5記載の電荷転送装置。

【請求項7】

半導体基板と、

該半導体基板中に形成された第1導電型半導体層からなり電荷を蓄積する第1

のウェル層とバリア層とが交互に配置される電荷転送路と、

該電荷転送路上において隣接して形成された複数の電荷転送電極と、

該電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn（nは2以上の整数）相驅動する第1のパルス信号列を印加できるとともに、前記電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn×m（mは2以上の整数）相以上で驅動する第3のパルス信号列を印加する第2のパルス信号発生回路と、

前記電荷転送電極の最終段に隣接して形成され前記電荷転送路内を転送された電荷を一時的に蓄積する電荷蓄積部と、

該電荷蓄積部に蓄積された電荷量を検出する電荷検出部と
を含み、

前記電荷蓄積部は、

前記電荷転送路に隣接して形成された第2のバリア層及び第2のウェル層と、

前記第2のバリア層と前記第2のウェル層との上に形成された第3の電荷転送電極および第4の電荷転送電極と、

前記第3の電荷転送電極及び前記第4の電荷転送電極と接続され、蓄積電荷放出用パルスを発生する蓄積電荷放出用パルス発生回路と
を含み、

前記第2のウェル層の電気容量が前記第1のウェル層の電気容量の（n×m-3）倍以上である
電荷転送装置。

【請求項8】

前記水平電荷転送路として請求項1から請求項7までのいずれかに記載の電荷転送装置が用いられる

固体撮像装置。

【請求項9】

半導体基板と、該半導体基板上に行方向及び列方向に整列して形成された複数の光電変換素子と、列方向に整列して配置された複数の前記光電変換素子列の各々に近接して配置され垂直方向に延びる複数の垂直電荷転送路と、前記光電変換素子の各々と前記垂直電荷転送路との間に形成され、前記光電変換素子に蓄積さ

れた電荷を前記垂直電荷転送路内に転送する読み出しゲートと、前記複数の垂直電荷転送路の一端に形成され、水平方向に電荷を転送する水平電荷転送路と、該水平電荷転送路により転送された電荷を増幅して外部に出力する出力アンプとを備え、前記水平電荷転送路は、前記半導体基板中に形成される第1導電型半導体層からなり、ポテンシャルの高い第1のバリア層とポテンシャルの低い第1のウェル層とが隣接して交互に配置された電荷転送路と、該電荷転送路上において前記第1のバリア層と前記第1のウェル層との上に隣接して交互に形成される複数の第1の電荷転送電極および第2の電荷転送電極と、前記第1の電荷転送電極とそれと隣接する前記第2の電荷転送電極とを相互に1つずつ接続して形成された複数の電荷転送電極対と、前記電荷転送路中の電荷を2相駆動する2相の第4のパルス信号列を隣接する2つの前記電荷転送電極対に対して印加できるとともに、前記電荷転送路中の電荷を $2k$ (k は2以上の整数) 相以上で駆動する第5のパルス信号列を前記電荷転送電極に対して印加する第3のパルス信号発生回路とを含む電荷転送装置の読み出し方法であって、

前記光電変換素子に蓄積された全ての光電変換素子に蓄積された電荷を読み出す際には、前記水平電荷転送路中の電荷を2相駆動方式で転送し、

水平方向に隣接する k 列の光電変換素子のうち1列を選択的に読み出す水平 $1/k$ 間引きを行い、前記水平電荷転送路中の電荷を $2k$ 相駆動方式で転送する固体撮像装置の読み出し方法。

【請求項10】

半導体基板と、該半導体基板上に行方向及び列方向に整列して形成された複数の光電変換素子と、列方向に整列して配置された複数の前記光電変換素子列の各々に近接して配置され、垂直方向に延びる複数の垂直電荷転送路と、前記光電変換素子と前記垂直電荷転送路との間に形成され、前記光電変換素子に蓄積された電荷を前記垂直電荷転送路内に転送する読み出しゲートと、前記複数の垂直電荷転送路の一端に形成され、水平方向に電荷を転送する水平電荷転送路と、該水平電荷転送路により転送された電荷を増幅して外部に出力する出力アンプとを備え、前記水平電荷転送路は、前記半導体基板中に形成される第1導電型半導体層からなり、ポテンシャルの高い第1のバリア層とポテンシャルの低い第1のウェル

層とが隣接して交互に配置された電荷転送路と、該電荷転送路上において前記第1のバリア層と前記第1のウェル層との上に隣接して交互に形成される複数の第1の電荷転送電極および第2の電荷転送電極と、前記第1の電荷転送電極とそれと隣接する前記第2の電荷転送電極とを相互に1つずつ接続して形成された複数の電荷転送電極対と、前記電荷転送路中の電荷を2相駆動する隣接する2相の第4のパルス信号列を2つの前記電荷転送電極対に対して印加するとともに、前記電荷転送路中の電荷を $2k$ (k は2以上の整数) 相以上で駆動する第5のパルス信号列を前記電荷転送電極に対して印加する第3のパルス信号発生回路とを含む電荷転送装置の読み出し方法であって、

前記光電変換素子に蓄積された全ての光電変換素子に蓄積された電荷を読み出す際には、前記水平電荷転送路中の電荷を2相駆動方式で転送し、

水平 j 列の光電変換素子の電荷信号を前記水平電荷転送路内において転送する際に加算して読み出す際に、前記水平電荷転送路を $2k$ 相駆動する固体撮像装置の読み出し方法。

【請求項11】

半導体基板と、該半導体基板上に行方向及び列方向に整列して形成された複数の光電変換素子と、列方向に整列して配置された複数の前記光電変換素子列の各々に近接して配置され、垂直方向に延びる複数の垂直電荷転送路と、前記光電変換素子と前記垂直電荷転送路との間に形成され、前記光電変換素子に蓄積された電荷を前記垂直電荷転送路内に転送する読み出しがと、前記複数の垂直電荷転送路の一端に形成され、複数の第1のウェル層に電荷を蓄積し、その電荷を水平方向に電荷を転送する水平電荷転送路と、該水平電荷転送路により転送された電荷を增幅して外部に出力する出力アンプとを備え、前記水平電荷転送路は、前記半導体基板中に形成される第1導電型半導体層からなり、前記水平電荷転送路上において隣接して形成された複数の電荷転送電極と、該電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷を n (n は2以上の整数) 相駆動する第1のパルス信号列を印加するとともに、前記電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷を $n \times m$ (m は2以上の整数) 相以上で駆動する第3のパルス信号列を印加する第2のパルス信号発生回路とを含み、さらに前記電荷転送電極の最終段に隣接して、

前記電荷転送路内を転送された電荷を一時的に蓄積する電荷蓄積部と、該電荷蓄積部に蓄積された電荷量を検出する電荷検出部とが形成され、前記電荷蓄積部は、前記電荷転送路上において隣接して形成された第2のバリア層及び第2のウェル層と、前記第2のバリア層と前記第2のウェル層との上に形成された第3の電荷転送電極および第4の電荷転送電極と、前記第3の電荷転送電極及び前記第4の電荷転送電極と接続され、蓄積電荷放出用パルスを発生する蓄積電荷放出用パルス発生回路とを含み、前記第2のウェル層の電気容量が前記第1のウェル層の電気容量の($n \times m - 3$)倍以上である固体撮像装置の読み出し方法であって、

前記電荷蓄積部に前記第1のウェル層の電気容量の($n \times m - 3$)倍以上の所定の電荷が蓄積された際に、前記電荷蓄積部から電荷検出部に電荷を転送する電荷転送装置の読み出し方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は電荷転送装置、それを用いた固体撮像装置及びその制御方法に関する

【0002】

【従来の技術】

図15に一般的な電荷転送装置の例を示す。図15(a)は平面図を、図15(b)は模式的な断面図を示す。

【0003】

図15(b)に示すように、電荷転送装置Xは、p型またはi型の表面層を有する半導体基板101と、その表面付近に形成されたn形半導体層105と、その上に絶縁膜115を介して形成された多結晶シリコンからなる電荷転送電極121と、電荷転送電極にパルス電圧を印加するパルス信号発生回路125を有している。

【0004】

電荷転送電極121は、第一層目のポリシリコン(1ポリ)により形成される第1の電荷転送電極121-1、121-3、121-5、…と、第二層目

のポリシリコン（2ポリ）により形成される第2の電荷転送電極121-2、121-4、121-6、・・・とが水平方向に交互に並んで配置されている。

【0005】

n形半導体層105のうち第一層目のポリシリコン（1ポリ）により形成される第1の電荷転送電極121-1、121-3、121-5、・・・の下の領域は、n形不純物の濃度が低く、ポテンシャルバリア（B）を形成する。第二層目のポリシリコン（2ポリ）により形成される第2の電荷転送電極121-2、121-4、121-6、・・・の下の領域は、n形不純物の濃度が高く、ポテンシャルウェル（W）を形成する。

【0006】

水平方向に隣接する第1及び第2の2つの電荷転送電極121、例えば第1の電荷転送電極121-1と第2の電荷転送電極121-2、或いは第1の電荷転送電極121-3と第2の電荷転送電極121-4とは、共通に配線されている。共通に配線された2つの電荷転送電極121-1と121-2とに、パルス信号発生回路125から信号波形 ϕ_2 が印加される。共通に配線された2つの電荷転送電極121-3と121-4とに、パルス信号発生回路125から信号波形 ϕ_1 が印加される。

【0007】

同様に、水平方向に隣接し、交互に並ぶ2つの電荷転送電極に、パルス信号発生回路125から、 ϕ_2 、 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_1 のように交互に異なる信号波形が印加される。

【0008】

図16に、パルス信号発生回路125から発生するパルス信号波形を示す。

【0009】

ϕ_1 は、LowとHighの電圧波形が交互に並ぶ信号波形である。

【0010】

ϕ_2 は、 ϕ_1 の逆相の信号波形である。

【0011】

ϕ_1 と ϕ_2 との信号波形が、図1に示す電荷転送装置Xに印加されることによ

り、図15(b)に示すように、電荷が2相駆動方式により水平方向に転送される。

【0012】

上記の2相駆動方式による電荷転送装置の他にも、3相駆動方式或いは4相駆動方式などにより電荷を転送する場合もある。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】

ここで、上述の2相駆動方式による電荷転送装置においては、2つの電荷転送電極121、121が1組となり、1組の電荷転送電極により電荷の1転送段を構成する。

【0014】

従って、上記のような2相駆動方式の電荷転送装置においては、電荷の1転送段は固定されている。

【0015】

図17に、図15に示す電荷転送装置Xを用いた固体撮像装置Aの平面図を示す。

【0016】

図17に示す固体撮像装置Aは、半導体基板101表面の2次元平面上に整列配置された複数の光電変換素子103、103、103と、各光電変換素子103に蓄積されている信号電荷を読み出し、読み出した電荷を列方向に順次転送する複数本の垂直電荷転送路105と、垂直電荷転送路105の一端に接続され垂直電荷転送路105から転送された電荷を水平方向に転送する水平電荷転送路107と、水平電荷転送路107から転送された電荷を增幅して外部に出力する出力アンプ111とを有する。

【0017】

光電変換素子103と垂直電荷転送路105との間には、光電変換素子103に蓄積されている電荷を垂直電荷転送路105に読み出すための読み出しゲート103aが設けられている。

【0018】

垂直電荷転送路105から水平電荷転送路107に向けて電荷が転送される。

【0019】

水平電荷転送路107として、前述の電荷転送装置Xを用いる。

【0020】

垂直電荷転送路105の一端は水平電荷転送路107のうち、ウェル層を形成する高濃度n形半導体層105aに接続されている。

【0021】

上記のような2相駆動形電荷転送装置は、2相駆動パルスで駆動される。

【0022】

その他、バリア層やウェル層を用いない3相駆動、4相駆動の従来型電荷転送装置においても、3相、4相パルスで駆動される装置は、それ以外の方法で電荷を駆動することはできなかった。

【0023】

例えば上述の2相駆動の電荷転送装置では、2つの電荷転送電極で電荷の1転送段を構成し、1転送段の幾何学的長さは固定される。

【0024】

このような制約は、電荷転送装置を固体撮像装置の水平電荷転送路として用了の場合に問題を生じる。

【0025】

すなわち、固体撮像装置においては、全ての画像信号を垂直電荷転送路から水平電荷転送路に転送できるように、水平電荷転送路の1転送段は1垂直電荷転送路に対応して設けられている。

【0026】

しかしながら、モニタ時には、画素数を間引いて高速の画像再生を行うことが望まれる。行数を間引くとともに、列数も同様に間引くことが望ましい。偶数列の信号電荷（電子）だけを選択的に転送しようとすると、信号電荷は、1列おきの偶数列の転送段のみに蓄積され、それと水平方向に隣接する奇数列の転送段は電荷が蓄積されない空の状態になる。この水平電荷転送路は、画像信号と空の信号とを共に信号として扱い、空の電荷を信号と同様にして転送する。

【0027】

従って、固体撮像装置における信号ビット数を減少させても、水平電荷転送路では、実質的なデータレートが減少せず、消費電力も低減しない。

【0028】

本発明の目的は、信号数に応じて転送段数を変化させ、データレートを高めること、消費電力を低減することができる電荷転送装置を用いた固体撮像装置を提供することを目的とする。

【0029】

【課題を解決するための手段】

本発明の一観点によれば、半導体基板と、該半導体基板中に形成された第1導電型半導体層からなる電荷転送路と、該電荷転送路上に近接して形成された複数の電荷転送電極と、該電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn（nは2以上の整数）相駆動する第1のパルス信号列を印加できるとともに、前記電荷転送電極に対して前記電荷転送路中の電荷をn+1相以上で駆動する第2のパルス信号列を印加できる第1のパルス信号発生回路とを含む電荷転送装置が提供される。

【0030】

本発明の他の観点によれば、半導体基板と、該半導体基板上に行方向及び列方向に整列して形成された複数の光電変換素子と、列方向に整列して配置された複数の前記光電変換素子列の各々に近接して配置され垂直方向に延びる複数の垂直電荷転送路と、前記光電変換素子の各々と前記垂直電荷転送路との間に形成され、前記光電変換素子に蓄積された電荷を前記垂直電荷転送路内に転送する読み出しゲートと、前記複数の垂直電荷転送路の一端に形成され、水平方向に電荷を転送する水平電荷転送路と、該水平電荷転送路により転送された電荷を増幅して外部に出力する出力アンプとを備え、前記水平電荷転送路は、前記半導体基板中に形成される第1導電型半導体層からなり、ポテンシャルの高い第1のバリア層とポテンシャルの低い第1のウェル層とが隣接して交互に配置された電荷転送路と、該電荷転送路上において前記第1のバリア層と前記第1のウェル層との上に隣接して交互に形成される複数の第1の電荷転送電極および第2の電荷転送電極と

、前記第1の電荷転送電極とそれと隣接する前記第2の電荷転送電極とを相互に1つずつ接続して形成された複数の電荷転送電極対と、前記電荷転送路中の電荷を2相駆動する2相の第4のパルス信号列を隣接する2つの前記電荷転送電極対に対して印加できるとともに、前記電荷転送路中の電荷を $2k$ （ k は2以上の整数）相以上で駆動する第5のパルス信号列を前記電荷転送電極に対して印加する第3のパルス信号発生回路とを含む電荷転送装置の読み出し方法であって、前記光電変換素子に蓄積された全ての光電変換素子に蓄積された電荷を読み出す際には、前記水平電荷転送路中の電荷を2相駆動方式で転送し、水平方向に隣接する k 列の光電変換素子のうち1列を選択的に読み出す水平 $1/k$ 間引きを行い、前記水平電荷転送路中の電荷を $2k$ 相駆動方式で転送する固体撮像装置の読み出し方法が提供される。

【0031】

【発明の実施の形態】

図1から図3までを用いて、本発明の第1の実施の形態による電荷転送装置について説明する。

【0032】

図1は平面図を、図2は模式的な断面図（図2（a））と電荷の分布を示す模式的な断面図（図2（b））を示す。第3図はパルス信号波形を示す。

【0033】

図1及び図2に示す電荷転送装置Aは、半導体基板1と、その表面付近に形成された第1導電型（n形）半導体層7と、その上に層間絶縁膜15を介して形成された多結晶シリコンからなる電荷転送電極21と、電荷転送電極にパルス電圧を印加するパルス信号発生回路25（25a、25b）とを有している。

【0034】

電荷転送電極21は、一般的に、第一層目のポリシリコン（1ポリ）により形成される電荷転送電極21-1、21-3、21-5、…と、第二層目のポリシリコン（2ポリ）により形成される電荷転送電極21-2、21-4、21-6、…とが水平方向に交互に並んで配置されている。

【0035】

n形半導体層7は、ほぼ均一な厚さ、不純物濃度の層を形成している。

【0036】

水平方向に隣接する8つの電荷転送電極21、例えば21-1から21-8までが1組の電荷転送電極群G1を形成する。

【0037】

電荷転送電極21-1に対して、パルス信号発生器25(25a)からφ1のパルス信号が印加される。

【0038】

電荷転送電極21-1と隣接する電荷転送電極21-2に対して、パルス信号発生器25(25a)からφ2のパルス信号が印加される。

【0039】

電荷転送電極21-2と隣接する電荷転送電極21-3に対して、パルス信号発生器25(25a)からφ3のパルス信号が印加される。

【0040】

電荷転送電極21-3と隣接する電荷転送電極21-4に対して、パルス信号発生器25(25a)からφ4のパルス信号が印加される。

【0041】

同様に、隣接する電荷転送電極21-5から21-8までに、φ1からφ4までのパルス信号が印加される。

【0042】

φ1からφ4までのパルス信号を第1のパルス信号列と称する。

【0043】

加えて同じ電荷転送電極21に対して、パルス信号発生器25(25b)から、1組の電荷転送電極群G1ごとにφ1からφ8までの異なるパルス信号が印加される。φ1からφ8までの異なるパルス信号を第2のパルス信号列と称する。

【0044】

電荷転送装置Aの転送電極21、21、21・・・に対して、第1のパルス信号列(4相駆動パルス)が印加されることにより、電荷駆動装置中の電荷は、4相駆動方式で転送される。

【0045】

尚、4相駆動以外にも3相駆動などn相（nは3以上の整数）駆動が可能である。

【0046】

電荷転送装置Aの転送電極21、21、21…に対して、第2のパルス信号列が印加されると、電荷駆動装置中の電荷は、8相駆動方式で転送される。

【0047】

8相駆動方式で動作させる場合には、4相駆動方式で動作させる場合の2倍の長さの転送段を有する。n（nは正の整数）相駆動方式では、4相駆動方式のn／4倍の長さの転送段を有する。

【0048】

尚、8相駆動以外にも、n+1相又はn×m（mは2以上の整数）で駆動しても良い。

【0049】

図3に、パルス信号発生回路25から発生する第2のパルス信号列の電圧波形の例を示す。

【0050】

電圧波形φ1から電圧波形φ8までは、横軸（時間）に対して、LowからHighへとφ1からφ8までの順に早く立ち上がり、HighからLowへとφ1からφ8までの順に早く立ち下がる。

【0051】

図3における時間t1、t2、t3の電荷転送装置Aの電荷分布を図2（b）に示す。垂直電荷転送路から転送された電荷信号は、t1からt3までの時刻を追って水平方向に転送される。従来の2相駆動の電荷転送に比べて空の転送段の割合が少なくなっている、電荷の転送効率が向上する。1周期に8電極分の駆動を行うため、電荷の転送速度が速くなる。

【0052】

尚、第1のパルス信号列と第2のパルス信号列とを印加するパルス信号発生器（回路）は、同じ回路中に含まれていても良いし、別の回路として設けられていい

ても良い。パルス信号発生器（回路）は、同じ半導体基板上に含まれていてもよいし、別の基板（チップ）中に含まれていても良い。

【0053】

図4および図5に、本発明の第2の実施の形態による固体撮像装置を示す。

【0054】

図4（a）に固体撮像装置の断面構造を、図4（b）に各電極に印加するパルス信号列を、図5に電荷転送の様子を示す。

【0055】

図4（a）に示すように、水平電荷転送路37の最終出力側に、最終転送電極F E、出力ゲートOG、フローティングディフュージョンFD領域（電荷検出層）、フローティングディフュージョンFD領域に蓄積されている電荷量を初期値にリセットするための電極であるリセットゲートRS、リセット時の電荷を流入するリセットドレインRDが形成されている。

【0056】

上記の基本的な構造は、第1の実施の形態による電荷転送装置と同様であるが、第2の実施の形態による電荷転送装置においては、水平電荷転送路の最終転送段に隣接して最終転送電極F Eが設けられている点が異なる。

【0057】

水平電荷転送路37内の電荷を6相駆動方式によりフローティングディフュージョンFD方向に向けて転送していく。最終転送電極F Eに、信号波形として $\phi_1 L$ を印加する。電荷は、最終転送電極F E下の半導体領域（n形半導体層）からなるウェル内に蓄積される。

【0058】

図4（b）に電極に印加するパルス信号列の例を示す。

【0059】

H i g hのパルス信号電圧が ϕ_1 から ϕ_6 までの順に印加される。6相駆動方式により水平電荷転送路内の電荷を転送する場合のパルス信号の例である。

【0060】

$\phi_1 L$ に対してH i g hの信号を印加することにより、最終転送電極F E下の

半導体領域（n形半導体層）からなるウェル内に電荷を蓄積し、L o wの信号を印加することにより蓄積された電荷をフローティングディフュージョンF D領域に転送する。

【0061】

図5に、図4（b）に示す時刻t1から時刻t7における電荷転送の様子を示す。

【0062】

時刻t1において、 ϕ_1 LにHighの電圧を印加する。最終転送電極FE下の半導体領域（n形半導体層）におけるポテンシャルが低くなり、そこにウェル層が形成される。 ϕ_1 にLow、 ϕ_2 から ϕ_5 までにHigh、 ϕ_6 にLowの電圧が印加される。Highの信号電圧が印加された水平電荷転送電極下の半導体領域に、電荷が蓄積される。 ϕ_6 の信号電圧がLowであるため、水平転送路の最終段の半導体領域に、ポテンシャルバリアが形成されている。従って、蓄積された電荷は、最終転送電極FE下の半導体領域に転送されない。

【0063】

時刻t2において、 ϕ_2 をLowにし、 ϕ_6 をHighにする。水平転送路の最終段の半導体領域に形成されていたポテンシャルバリアがなくなる。従って、水平電荷転送路の最終段に蓄積されていた電荷は、最終転送電極FE下の半導体領域に転送される。転送された電荷は、その領域内に形成されているウェル内に蓄積される。

【0064】

時刻t3において、 ϕ_3 がLowになる。水平電荷転送路内の電荷がさらに最終転送電極FE下の半導体領域に転送される。転送された電荷は、さらに、その領域内に形成されているウェル内に蓄積される。

【0065】

時刻t4において、 ϕ_4 がLowになる。水平電荷転送路内の電荷がさらに最終転送電極FE下の半導体領域に転送される。転送された電荷は、さらに、その領域内に形成されているウェル内に蓄積される。

【0066】

時刻 t_5 において ϕ_5 が Low になり、上記と同様に電荷は最終転送電極 F E 下の半導体領域に形成されたウェル内にさらに転送され、蓄積される。

【0067】

時刻 t_6 において ϕ_6 が Low になり、上記と同様に電荷は最終転送電極 F E 下の半導体領域に形成されたウェル内にさらに転送され、蓄積される。

【0068】

時刻 t_7 において、出力ゲート O G に High の電圧を印加し、 $\phi_1 L$ に Low の電圧を印加する。最終転送電極 F E 下の半導体領域に蓄積された電荷は、導領域内のポテンシャルが上がるため、フローティングディフュージョン F D 領域に転送される。

【0069】

同様の動作を繰り返すことにより、水平電荷転送路内に転送された電荷は、時間の経過 (t_1 から t_6 まで) とともに最終転送電極 F E 下の半導体領域 (n 形半導体層) 内に形成されたウェル内に徐々に蓄積されていく。時間 t_7 において、蓄積された電荷は、一時にフローティングディフュージョン F D 領域に転送される。

【0070】

水平電荷転送路 3 7 を 6 相駆動方式で駆動するにもかかわらず、6 相目のパルス信号が印加された際に初めて電荷検出層中に電荷が転送される。出力信号波形は、水平電荷転送路 3 7 内の電荷を 2 相駆動方式で転送した場合と比べて出力周波数が異なるものの、データレートが同じになる。

【0071】

上記の方法によれば、フローティングディフュージョン F D における信号ホールド時間を長くすることができる。

【0072】

最終転送電極 F E に電荷を一時的に蓄積し、蓄積された電荷を一時にフローティングディフュージョンに転送することができる。信号の検出、出力タイミングと出力期間をほぼ任意に設定でき、信号処理に適した出力を得ることができる。

【0073】

CDS処理（相関二重サンプリング回路による処理）等の雑音低減処理を行うことができる。

【0074】

次に、図6から図8までを用いて、本発明の第3の実施の形態による電荷転送装置について説明する。

【0075】

図6は平面図を、図7は模式的な断面図（図7（a））と電荷の分布を示す模式的な断面図（図7（b））を示す。第8図はパルス信号波形を示す。

【0076】

図6及び図7に示す電荷転送装置Bは、前述の電荷転送装置Aと同様に、半導体基板1と、その表面付近に形成されたn形半導体層7と、その上に層間絶縁膜15を介して形成された多結晶シリコンからなる電荷転送電極21と、電荷転送電極にパルス電圧を印加するパルス信号発生回路25（25a、25b）とを有している。

【0077】

電荷転送電極21は、一般的に、第一層目のポリシリコン（1ポリ）により形成される電荷転送電極21-1、21-3、21-5、・・・と、第二層目のポリシリコン（2ポリ）により形成される電荷転送電極21-2、21-4、21-6、・・・とが水平方向に交互に並んで配置されている。

【0078】

n形半導体層7のうち第一層目のポリシリコン（1ポリ）により形成される電荷転送電極21-1、21-3、21-5、・・・の下の領域は、n形不純物の濃度が低く、ポテンシャルバリアを形成する。第二層目のポリシリコン（2ポリ）により形成される電荷転送電極21-2、21-4、21-6、・・・の下の領域は、n形不純物の濃度が高く、ポテンシャルウェルを形成する。

【0079】

水平方向に隣接する2つの電荷転送電極21、例えば電荷転送電極21-1と電荷転送電極21-2、電荷転送電極21-3と電荷転送電極21-4とは、共通に配線されている。

【0080】

共通に配線された2つの電荷転送電極21-1と21-2とに、パルス信号発生回路25(25c)から信号波形 ϕ_2 が印加される。

【0081】

共通に配線された2つの電荷転送電極21-3と21-4とに、パルス信号発生回路25(25c)から信号波形 ϕ_1 が印加される。

【0082】

共通に配線された2つの電荷転送電極21-5と21-6とに、パルス信号発生回路25(25c)から信号波形 ϕ_2 が印加される。

【0083】

同様に、水平方向に隣接し、交互に並ぶ2つの電荷転送電極に、パルス信号発生回路25(25c)から、 ϕ_2 、 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_1 と交互に異なる信号波形が印加される。

【0084】

加えて、電荷転送電極21-1から21-6までに対して、 ϕ_1 から ϕ_6 までの電圧波形を独立に印加するパルス信号発生回路25(25d)が設けられている。

【0085】

電荷転送装置Aの転送電極21、21、21…に対して、1電極対ごとに ϕ_1 と ϕ_2 との2相パルスを供給すると2相駆動CCDとして動作する。

【0086】

電荷転送装置Aの転送電極21、21、21…に対して、1電極対ごとに ϕ_1 から ϕ_6 までの6相のパルスを供給すると6相駆動CCDとして動作する。

【0087】

6相駆動方式で動作させる場合には、2相駆動方式で動作させる場合の3倍の長さの転送段を有する。 k (k は正の整数)相駆動方式では、2相駆動方式の $k/2$ 倍の長さの転送段を有する。

【0088】

図8に、パルス信号発生回路25(25d)の6相パルス信号波形の例を示す

【0089】

電圧波形 ϕ_1 から電圧波形 ϕ_6 までは、横軸（時間）に対して、LowからHighへと ϕ_1 から ϕ_6 までの順に早く立ち上がり、HighからLowへと ϕ_1 から ϕ_6 までの順に早く立ち下がる。信号波形がHighである期間は ϕ_1 から ϕ_6 までの期間とほぼ等しくなっている。

【0090】

図8における時間 t_1 、 t_2 、 t_3 の電荷転送装置Aの電荷分布を図7 (b) に示す。垂直電荷転送路から転送された電荷信号は、 t_1 から t_3 までの時刻を追って水平方向に転送される。従来の2相駆動の電荷転送に比べて空の転送段の割合が少なくなっている、電荷の転送効率が向上する。

【0091】

尚、 n 相駆動と $n \times m$ (m は2以上の整数) 駆動との両方の駆動方式で電荷を駆動する場合、第2のウェル層（最終転送電極FE下の半導体領域）の電気容量が第1のウェル層（水平電荷転送路内のウェル領域）の電気容量の $(n \times m - 3)$ 倍以上であれば良い。

【0092】

例えば、図8において、時刻 t_1 と時刻 t_2 との間には、6電極のうち3電極がLowになる時間が存在する。このような状態が、パルス信号電圧の位相マージンをとりやすい状態といえる。3電極分がLowであるために、ウェルのうち3つ分のウェルには電荷が蓄積されていない状態となる。

【0093】

従って、上記 $(n \times m - 3)$ 倍という値が妥当と言える。

【0094】

図9及び図10を参照して、本発明の第4の実施の形態による固体撮像装置について説明する。

【0095】

図9に示すように、本発明の第4の実施の形態による固体撮像装置Cは、半導体基板31と、半導体基板31上に形成された整列配置された光電変換素子33

、33、33と、列方向（垂直方向）に整列した光電変換素子33に対応して1本づつ設けられ垂直方向に伸びる垂直電荷転送路35、35、35と、垂直電荷転送路35を水平方向に区画するよう垂直方向に伸びるチャネルトップ41と、垂直電荷転送路35の垂直方向の一端に接続され水平方向に伸びる水平電荷転送路37とを含む。

【0096】

さらに、1行の光電変換素子33に対応して水平方向に延びるように2本設けられる複数の垂直電荷転送電極EV(EV1、EV2、・・・、EV12)と、水平電荷転送路37上において1ポリと2ポリにより水平方向に交互に形成される水平電荷転送電極EH(EH1、EH2、EH3、・・・)と、光電変換素子33と垂直電荷転送路35との間に設けられ、光電変換素子33に蓄積された電荷を垂直電荷転送路35に読み出すための読み出しゲート33aが形成されている。

【0097】

さらに、垂直電荷転送電極EV、水平電荷転送電極EHに印加するパルス信号を発生するパルス信号発生器25(25a、25b、25c)が設けられている。

【0098】

水平電荷転送電極EHは、水平方向に隣接する2つの水平電荷転送電極、例えばEH1とEH2とが共通に配線されている。EH3とEH4とに関しても同様に配線されている。

【0099】

水平電荷転送電極にパルス電圧を印加するためのパルス信号発生器25a、25bは上記のパルス信号発生器25の一部を形成している。

【0100】

垂直電荷転送電極にパルス電圧を印加するためのパルス信号発生器25cも、上記のパルス信号発生器25の一部を形成している。

【0101】

光電変換素子33は、緑色(G)の光電変換素子33aと、赤色(R)の光電

変換素子33bと、青色（B）の光電変換素子33cとを含む。

【0102】

垂直方向に整列配置された複数のG電荷が、1列おきに配置されている。

【0103】

垂直方向にG電荷が配置されている列と水平方向に隣接する列内にはG電荷のピッチの1／2分ずれた位置に、B電荷とR電荷とが垂直方向に交互に配置されている。いわゆる画素ずらし構成の固体撮像装置である。

【0104】

水平方向にG電荷が整列配置されている行と垂直方向に隣接する行に、B電荷とR電荷とが整列して配置されている。

【0105】

図には、この画素ずらし構成の固体撮像装置において、全画素からの信号を読み出す際の信号電荷の転送の様子が示されている。

【0106】

垂直電荷転送路35内において、1水平ラインにRGBG……の順で配置された電荷信号が並列に転送される様子が示されている。

【0107】

水平方向に隣接したk列分の光電変換素子からの電荷信号を、水平電荷転送路内において転送する際に加算読み出しを行う場合には、水平電荷転送路内の電荷を2k相で駆動する。

【0108】

水平電荷転送路37に転送された後に、パルス信号発生器25(25b)により、水平電荷転送電極EHに対して6相駆動パルスを印加すると、R+G+Bの合成信号、2G+Rの合成信号、2G+Bの合成信号がパルス信号発生器25(25a)により水平電荷転送電極EHに対して2相駆動方式を用いた場合の1／3のデータレートで外部に出力される。この出力信号を信号処理回路により処理することで、モニター画像が表示される。

【0109】

尚、水平電荷転送電極EHに対して2相駆動の信号パルスを印加して2相駆動

方式で駆動すれば、通常の固体撮像装置の場合と同様に、全画素からの電荷の読み出しが可能である。

【0110】

次に上記の実施の形態による固体撮像装置の制御方法の変形例を図10に示す。

【0111】

図10に示す固体撮像装置は図9に示す固体撮像装置と同様の構成を有している。

【0112】

光電変換素子33に蓄積された電荷を垂直電荷転送路35に読み出す際に、例えば、 ϕv_2 に対して高い正の電圧、例えば15Vの電圧を印加する。

【0113】

光電変換素子33のうち青色(B)の光電変換素子と、赤色(R)の光電変換素子から、垂直電荷転送路35に電荷が転送される。

【0114】

垂直電荷転送路35に転送された電荷は、垂直電荷転送路内を垂直電荷転送電極に対して ϕv_1 から ϕv_4 までの信号電圧を印加することにより、4相駆動方式で水平電荷転送路方向に電荷を転送する。

【0115】

尚、同じ行に形成されている同色の光電変換素子において、読み出しゲートの位置を適宜変化させている。

【0116】

例えば、 ϕv_2 に読み出しパルス電圧を印加した場合に、同じ行にならぶ青色又は赤色の電荷のうち、所定の光電変換素子のみからの電荷が読み出されるようになる。すなわち、 ϕv_1 又は ϕv_2 に対応するように光電変換素子の上下のいずれかに読み出しゲートが形成されるように同じ行に配置されている同色の光電変換素子においても、各々、読み出しゲートの形成される位置を変えている。

【0117】

図10に示す固体撮像装置の制御方法によれば、垂直電荷転送電極EVのうち

所定の電極に対して読み出し電圧を印加することにより、4行の光電変換素子33のうち1行の光電変換素子33のみから電荷を読み出す（垂直1／4間引き読み出し）。

【0118】

さらに、垂直電荷転送路35内の電荷のうち3列ごとに1列だけ存在する電荷を水平電荷転送路37に転送する（水平1／3間引き読み出し）。

【0119】

水平方向に隣接するk列の光電変換素子のうち1列を選択的に読み出す水平1／k間引きを行い、前記水平電荷転送路中の電荷を2k相駆動方式で転送する

水平電荷転送路37を6相駆動することにより、φ1からφ6までの6相の電圧波形が印加される。6相駆動方式により電荷を転送するため、垂直電荷転送路から転送された3列につき1列存在する電荷を、空の信号電荷転送が生じないように転送される。

【0120】

上記の動作により、水平方向に1／3に間引かれた電荷信号が出力される。

【0121】

図10に示す実施例では、間引かれて外部に出力された信号も、RGBGの順に出力される。

【0122】

従って、この固体撮像装置をデジタルスチルカメラに使用した際の動画モニタ画像等を表示するのに有用であり、かつ、モニタ画像を鮮明に表示することができる。

【0123】

水平電荷転送路において電荷を6相駆動することにより、データレートの減少に伴い駆動パルスの周波数が1／3に低下する。消費電力も1／3に削減することができる。

【0124】

本発明の第5の実施の形態による固体撮像装置について図11から図14までに基づいて説明する。

【0125】

図11及び図14までに示す構造は、2つで1組の水平電荷転送電極E Hに対して ϕ_1 から ϕ_4 までの4本の給電線が接続されている。

【0126】

図11は全画素読み出しを行う場合の読み出し方法を説明した図である。

【0127】

光電変換素子33、33、33の色配列は、R、G、Bの光電変換素子が垂直方向に整列配置されたRGB縦ストライプ色フィルタ配列である。

【0128】

図12は、水平電荷転送路37を2相駆動する場合のパルス波形を示す。

【0129】

ϕ_1 と ϕ_3 とが同じ信号波形であり、 ϕ_2 と ϕ_4 は同じ信号波形である。

【0130】

従って、通常の2相駆動方式による水平電荷転送路の電荷転送と同様に、全ての光電変換素子からの電荷を外部に読み出すことができる。

【0131】

図13は、図11と同じ構成を有している。垂直1／2間引き読み出し、水平1／2間引き読み出しを行ったときの画像信号の分布を示す。水平1／2間引き読み出し法においても、RGBストライプの信号が外部に出力される。

【0132】

図14に、図13に示す垂直1／2間引き読み出し、水平1／2間引き読み出し法における水平電荷転送電極E Hに印加するパルス信号波形を示す。

【0133】

パルス波形は、LowからHighへの電圧の立ち上がりが、 ϕ_1 から ϕ_4 に向けて順に遅れ、HighからLowへの電圧の立ち下がりが、 ϕ_1 から ϕ_4 に向けて順に遅れる波形である。

【0134】

水平電荷転送電極E Hに4相駆動パルスを印加することにより、空転送なしに水平1／2間引き動作を行うことができる。

【0135】

消費電力も1/2に低減する。

【0136】

また、画素の形状としては、正六角形の画素を有するものについて説明したが
方形、多角形の画素に適用しても良い。

【0137】

その他、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者には自明で
あろう。

【0138】

【発明の効果】

以上説明した通り、本発明の電荷転送装置においては、供給するパルス位相に
より、1転送段の長さを変化させることができる。

【0139】

また、電子スチルカメラにおける1/2、1/3、1/4間引き等のモニタ画
像撮像動作を空転送なしに実現できる。消費電力の削減が可能となる。

【0140】

データレートを高めることができ、低消費電力で高品質なモニタ画像の表示が
可能となる。

【0141】

多相動作により、信号転送容量を大幅に増加することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態による電荷転送装置の平面図である。

【図2】 (a) は、図1に対応する断面構造を示し、(b) は電荷転送の
様子を示す。

【図3】 図2に示す電荷転送の際に水平電荷転送電極に印加されるパルス
信号波形である。

【図4】 本発明の第2の実施の形態による固体撮像装置の平面図であり、
電荷読み出しの方法を示す。(b) はパルス信号波形を示す。

【図5】 本発明の第2の実施の形態による固体撮像装置の電荷転送の様子

を示す。

【図6】 本発明の第3の実施の形態による電荷転送装置の平面図である。

【図7】 (a) は、図6に対応する断面構造を示し、(b) は電荷転送の様子を示す。

【図8】 図7に示す電荷転送の際に水平電荷転送電極に印加されるパルス信号波形である。

【図9】 本発明の第4の実施の形態による固体撮像装置の平面図である。

【図10】 図9の変形例であり、間引き読み出し方法を示す。

【図11】 本発明の第5の実施の形態による固体撮像装置の平面図であり、電荷読み出しの方法を示す。

【図12】 図11に示す電荷読み出しの際に水平電荷転送電極に印加されるパルス信号波形である。

【図13】 本発明の第5の実施の形態による固体撮像装置の変形例を示す平面図であり、間引き読み出しによる電荷読み出しの方法を示す。

【図14】 図13に示す電荷読み出しの際に水平電荷転送電極に印加されるパルス信号波形である。

【図15】 従来の2相駆動方式の電荷転送装置であり(a) は平面図、(b) は断面図と電荷の転送の様子を示す図である。

【図16】 従来の2相駆動方式の電荷転送装置に印加するパルス信号の信号波形である。

【図17】 従来の固体撮像装置の平面図である。

【符号の説明】

A、B 電荷転送装置

C、D、E、F 固体撮像装置

E V 垂直電荷転送電極

E H 水平電荷転送電極

F D フローティングディフュージョン

F E 最終電荷転送電極

1 半導体装置

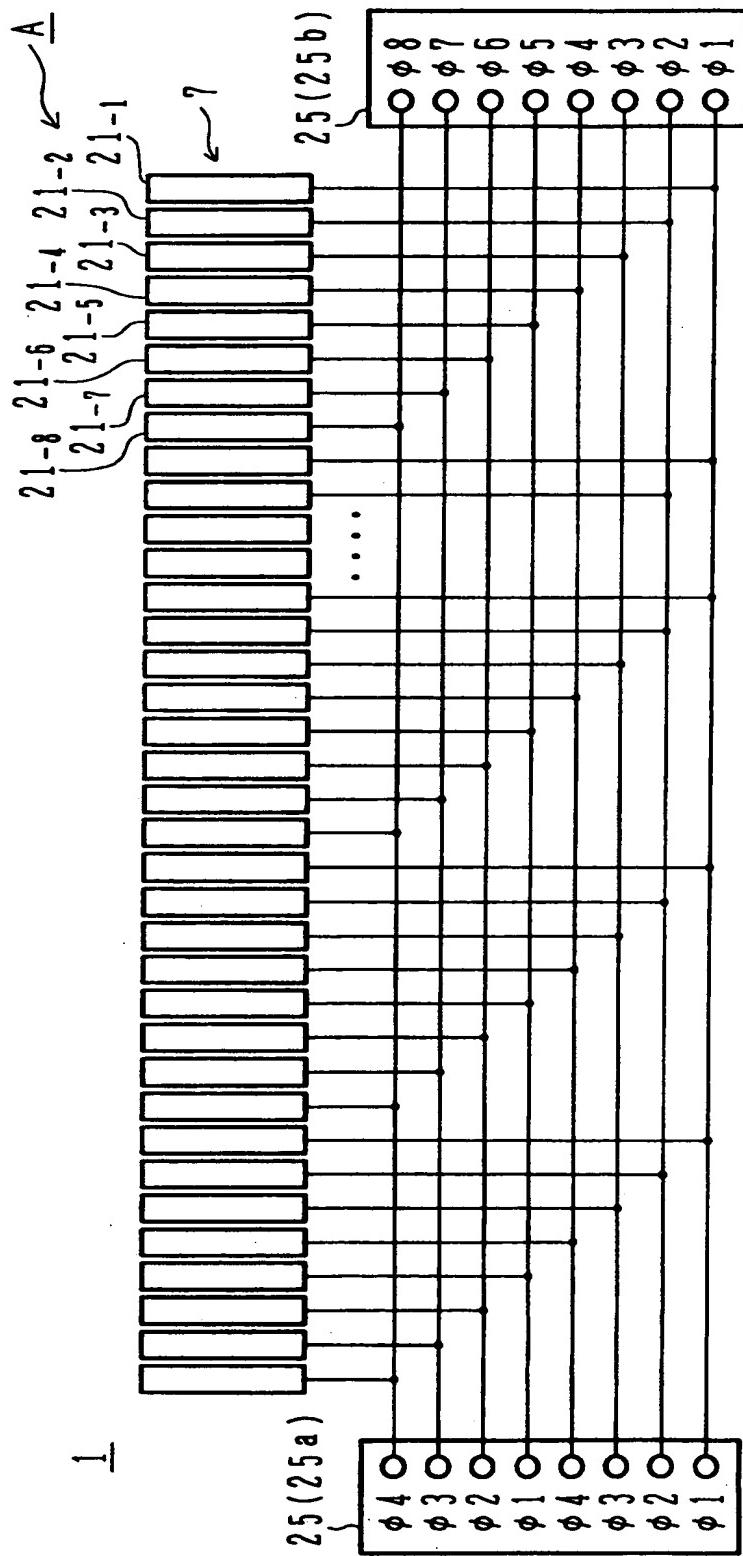
- 7 水平電荷転送路
- 25 パルス信号発生回路
- 33 光電変換素子
- 33a 読み出しゲート
- 35 垂直電荷転送路
- 37 水平電荷転送路
- 41 チャネルトップ

【書類名】

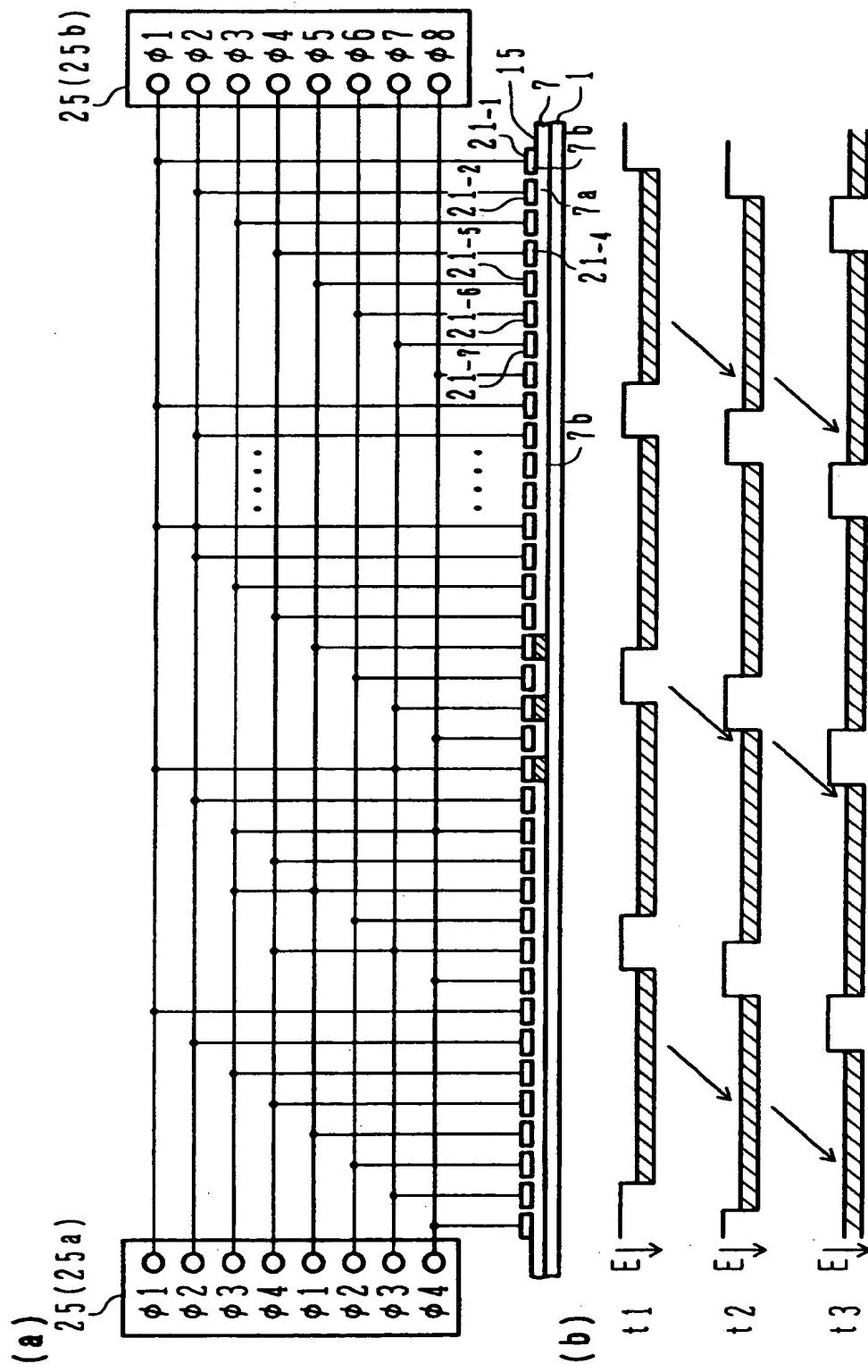
図面

【図1】

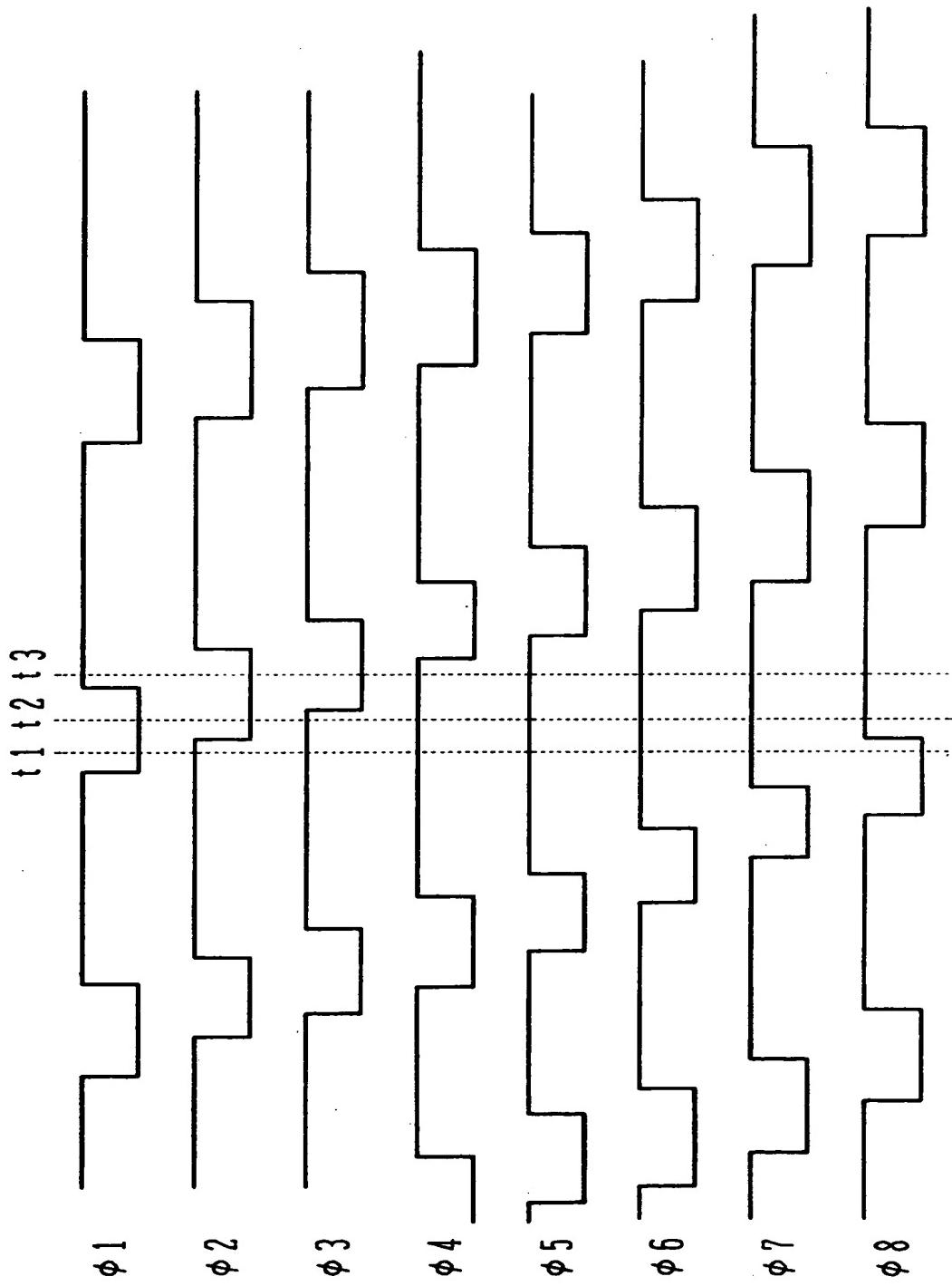
第1の実施例



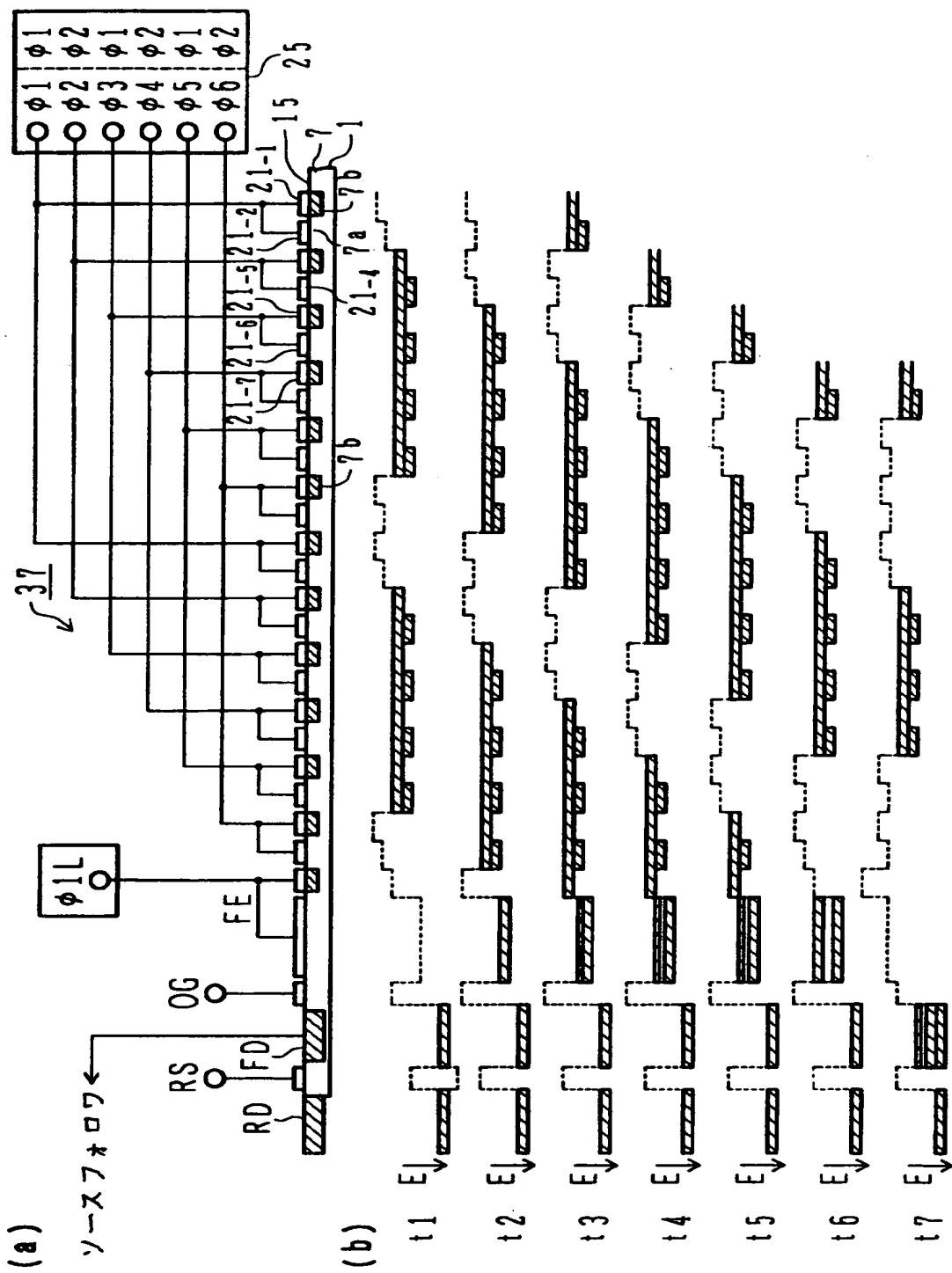
【図2】



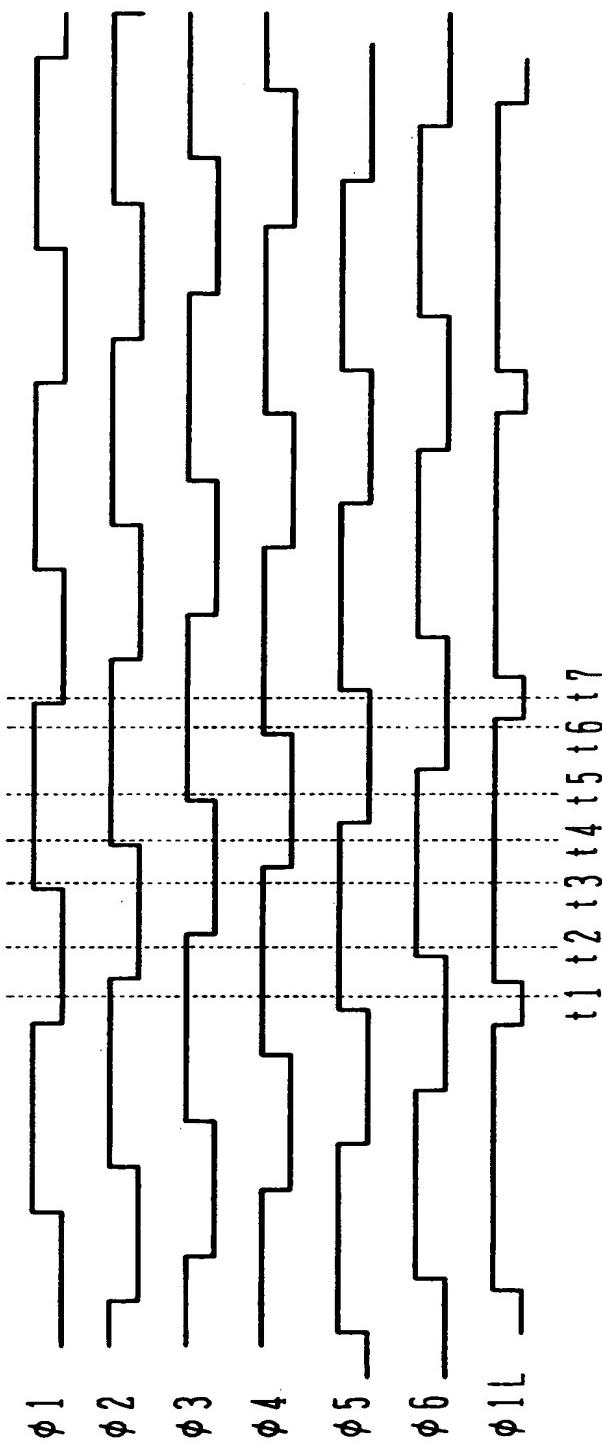
【図3】



【図4】

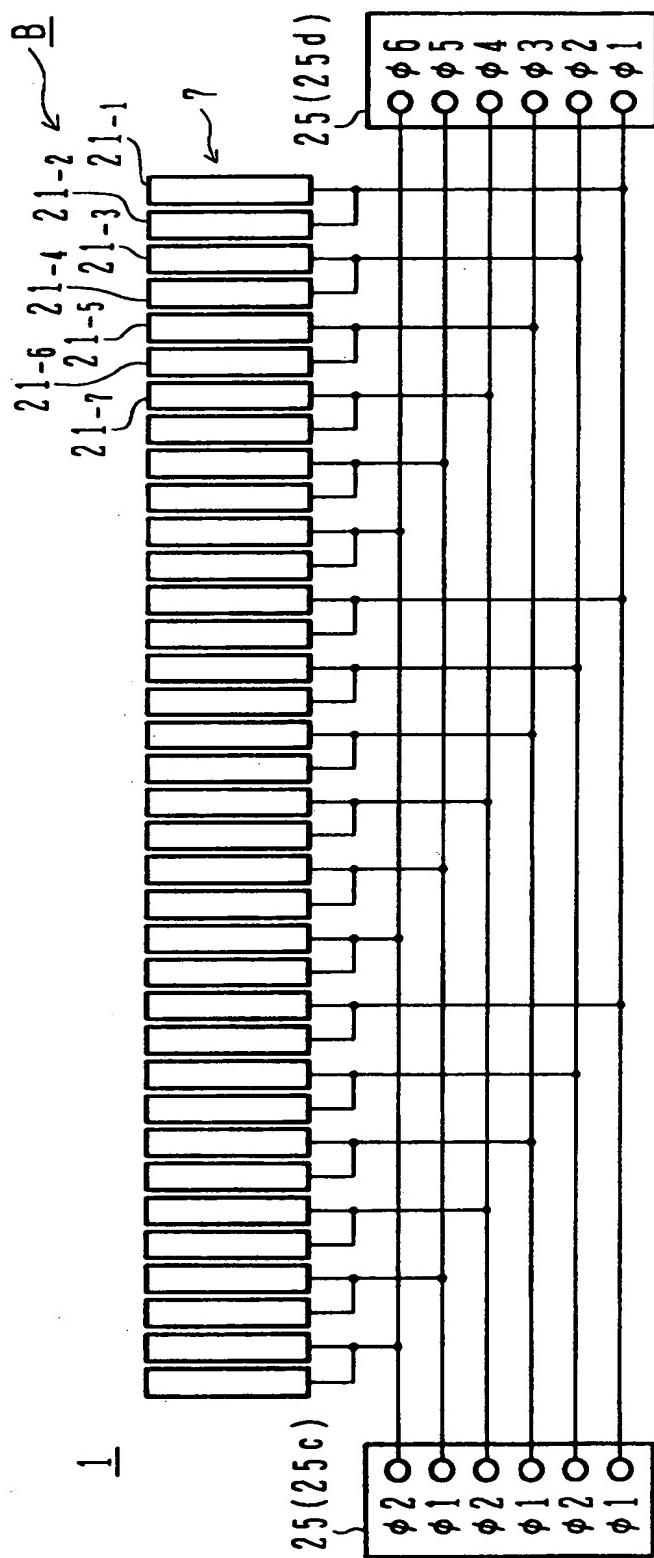


【図5】

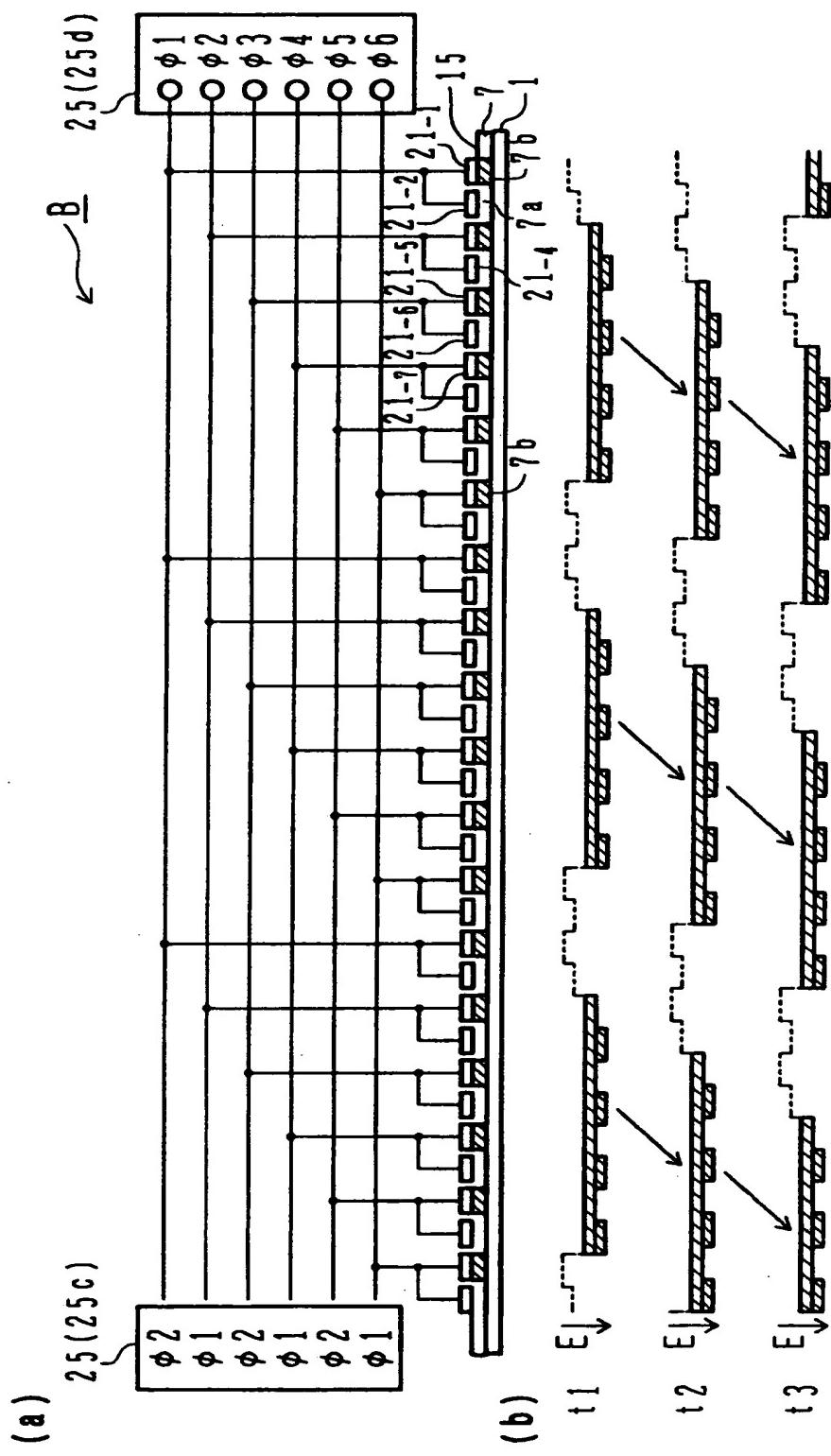


【図6】

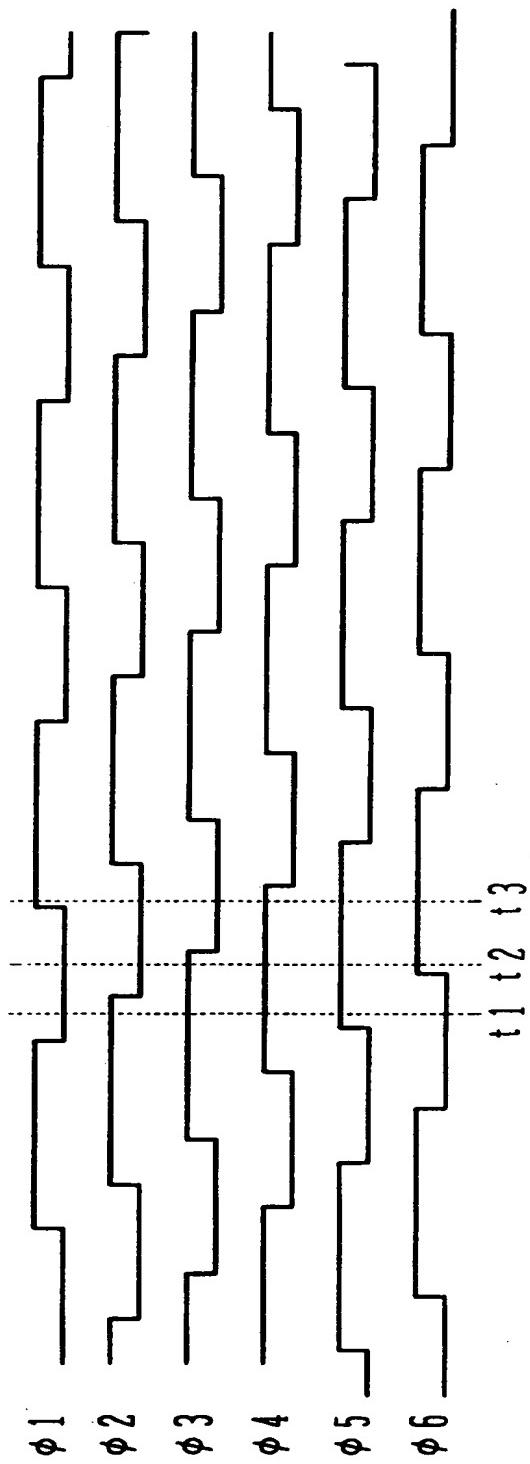
第2の実施例



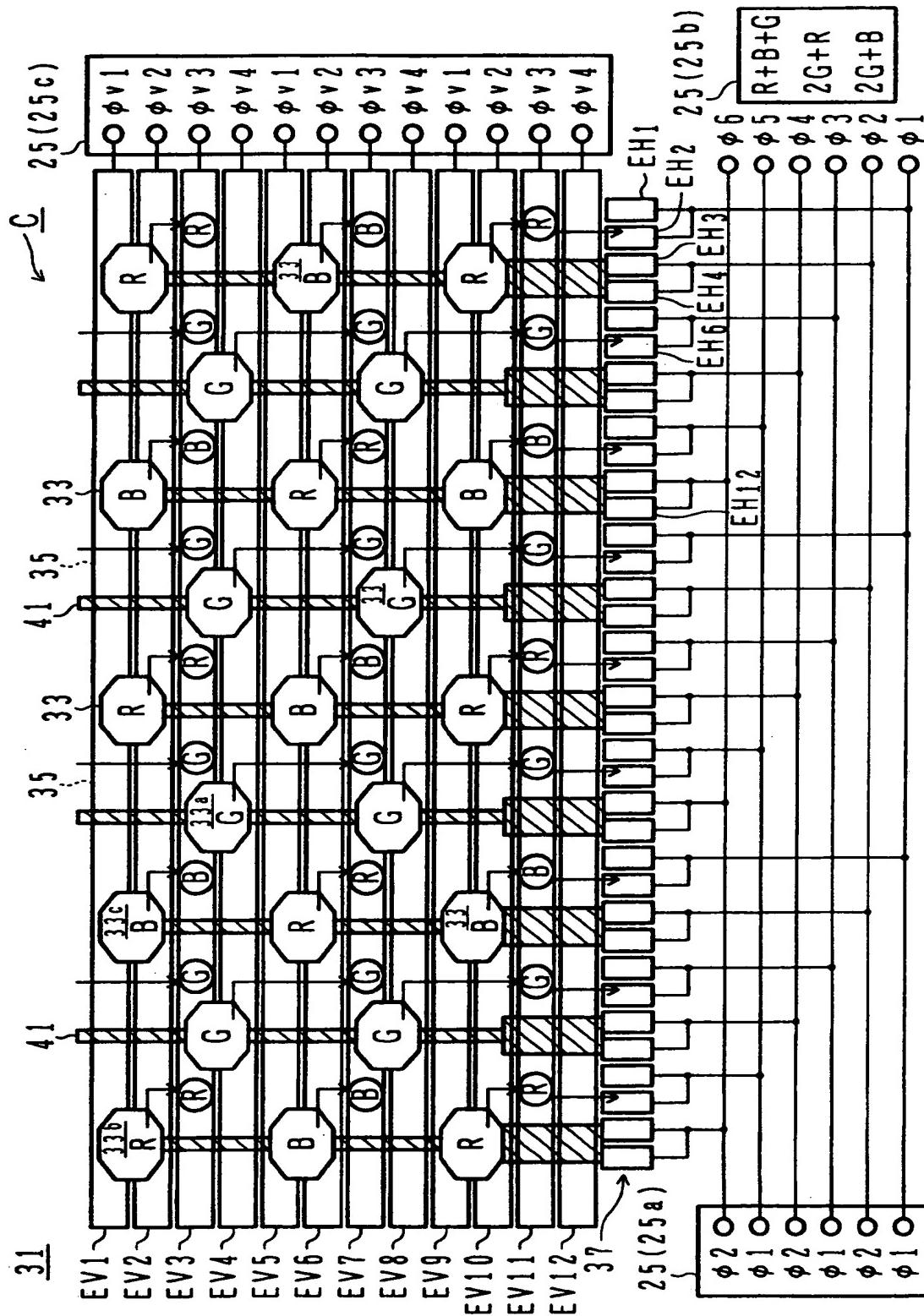
【図7】



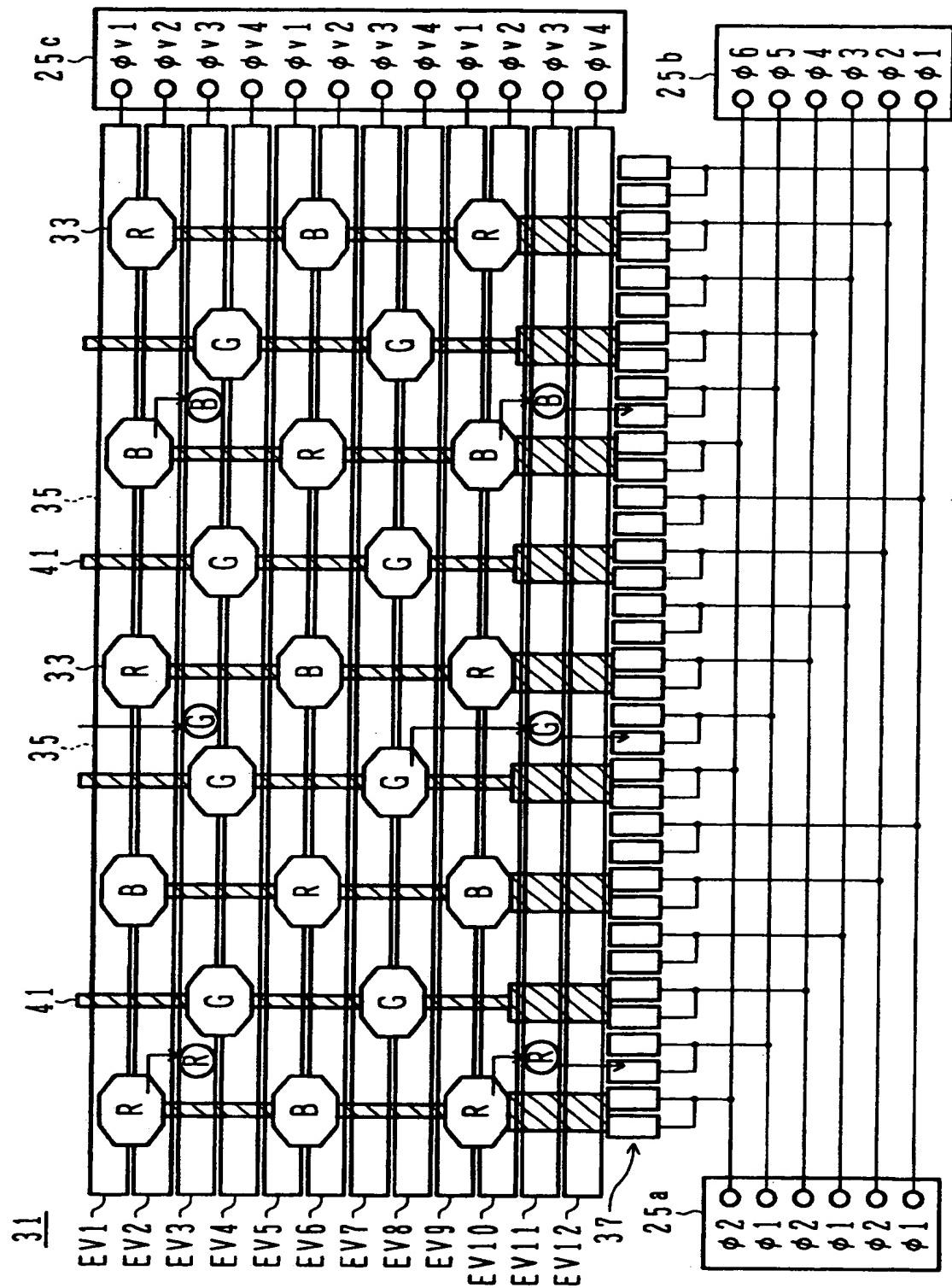
【図8】



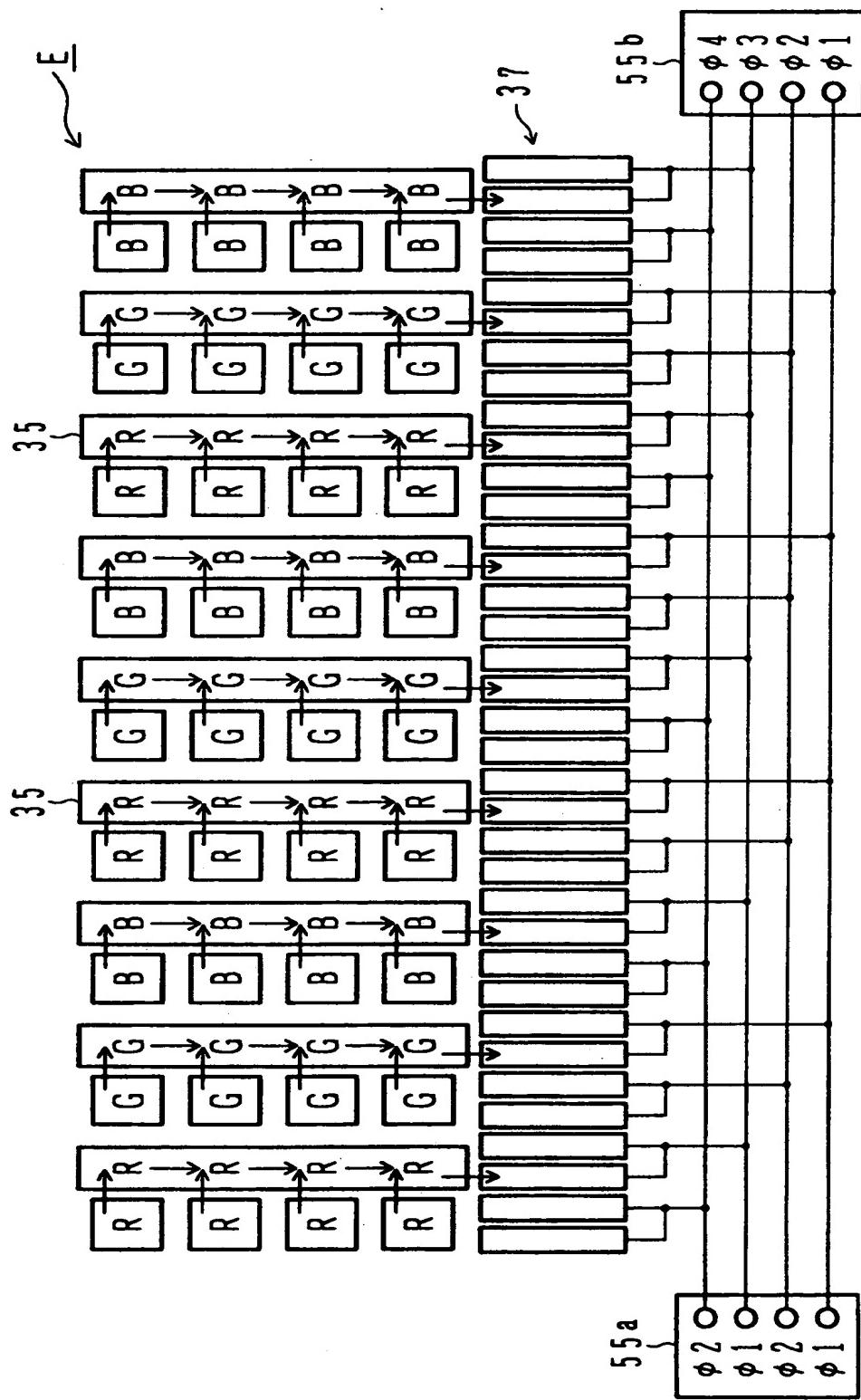
【図9】



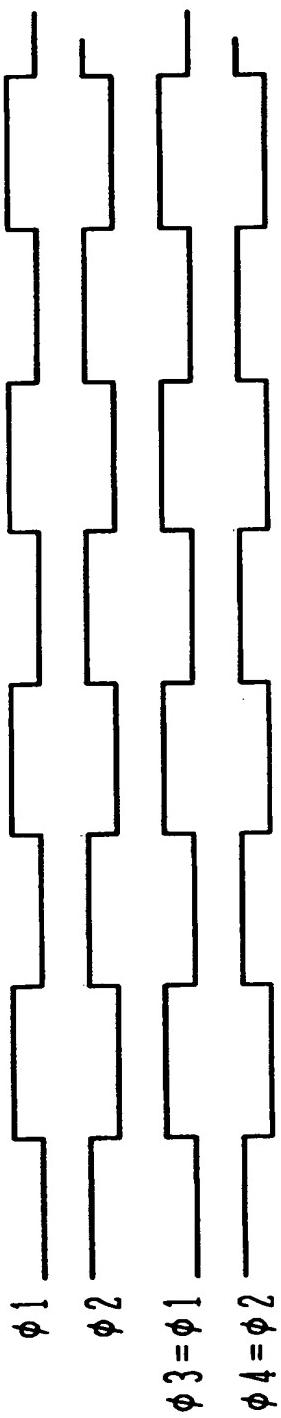
【図10】



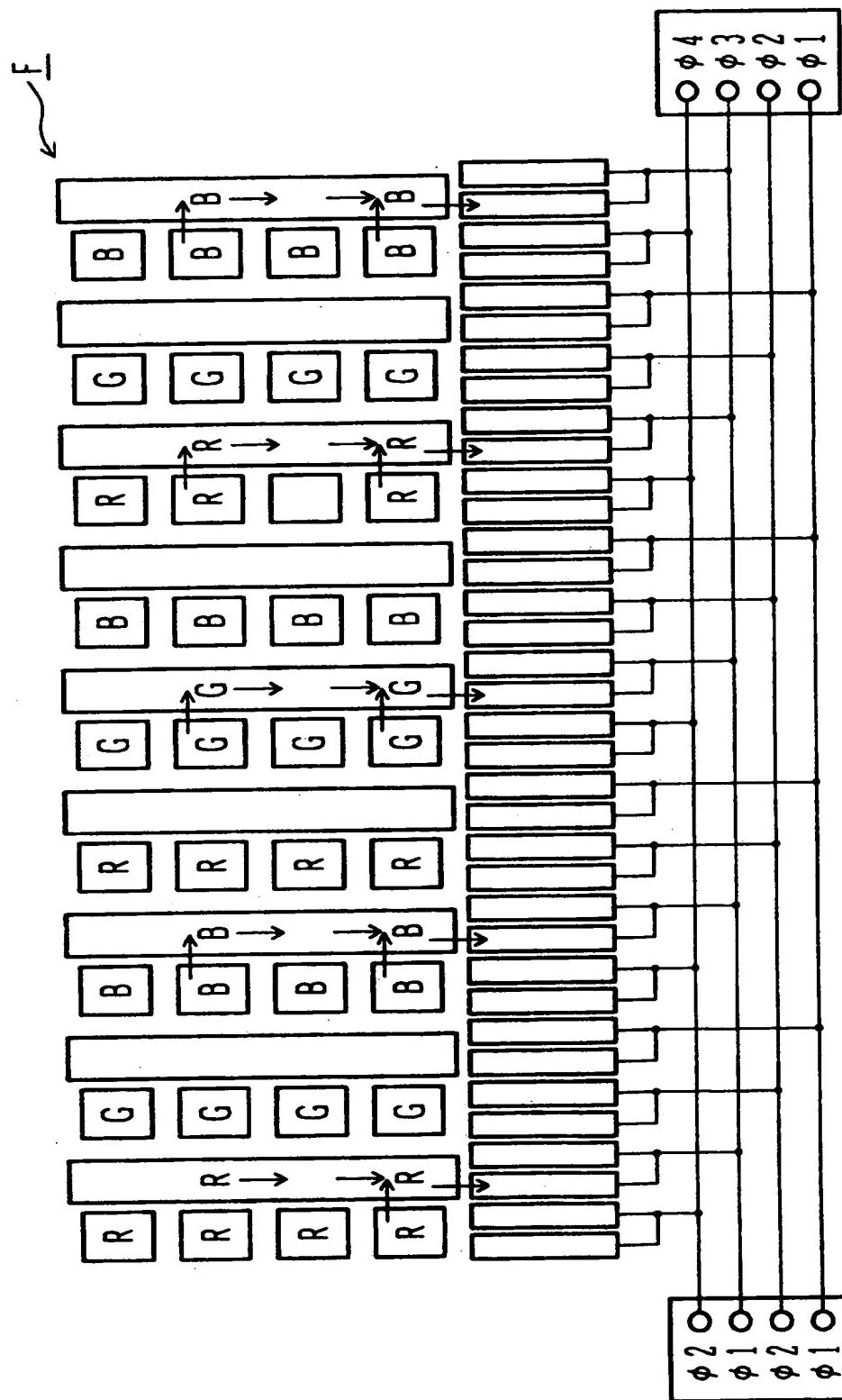
【図11】



【図12】

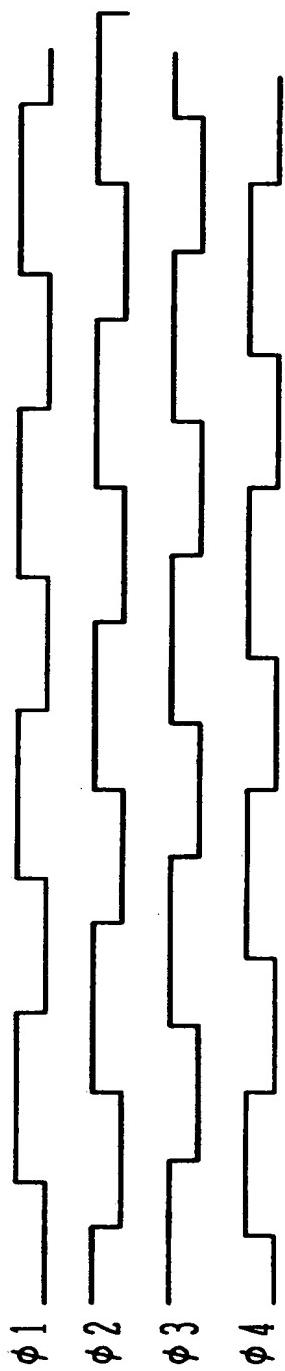


【図13】



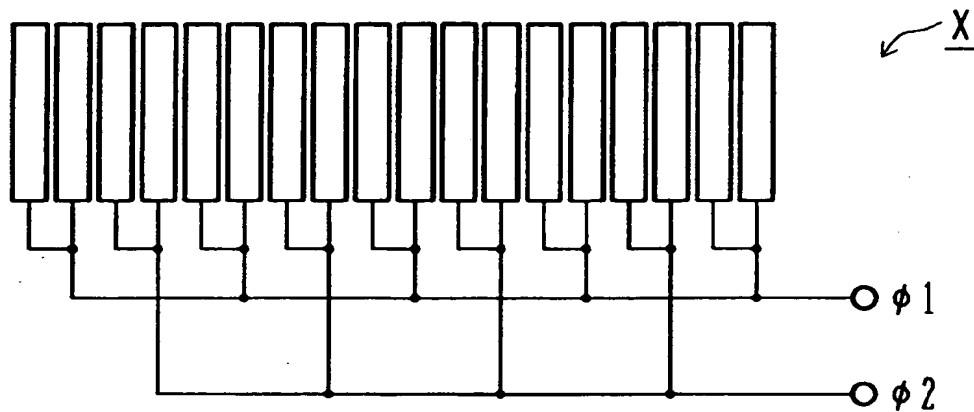
特平11-287338

【図14】

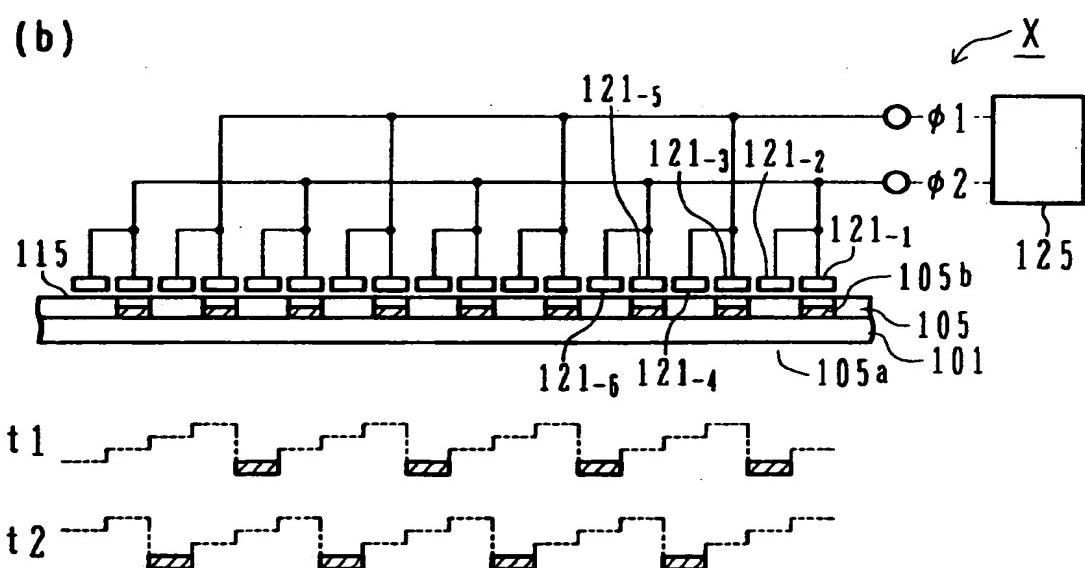


【図15】

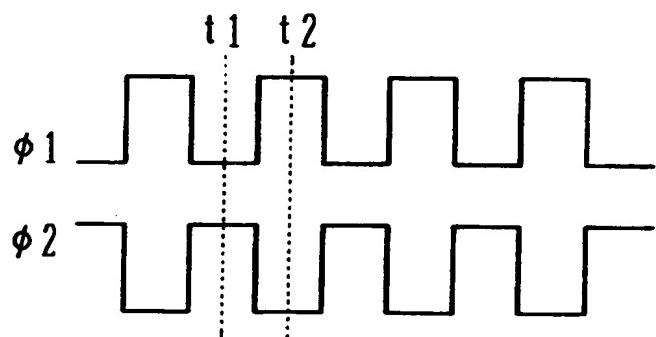
(a)



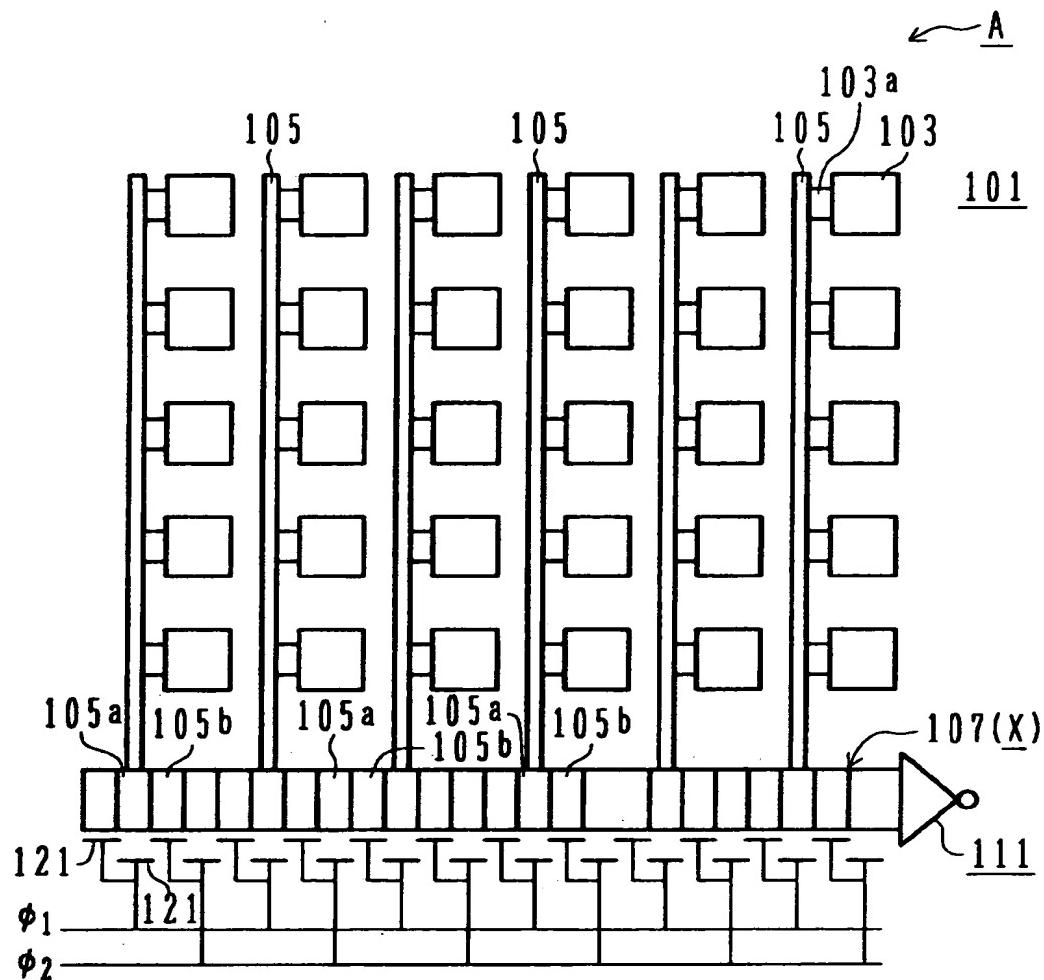
(b)



【図16】



【図17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電荷転送装置のデータレートを高め、低消費電力化を図る。

【解決手段】 半導体基板1と、その中に形成された第1導電型半導体層からなる電荷転送路7と、その上において近接して形成された複数の電荷転送電極21と、それに対して電荷転送路中の電荷をn（nは2以上の整数）相駆動する第1のパルス信号列を印加できるとともに、電荷転送電極21に対して電荷転送路7中の電荷をn+1相以上で駆動する第2のパルス信号列を印加できるパルス信号発生回路25とを含む。

【選択図】 図4

出願人履歴情報

識別番号 [391051588]

1. 変更年月日 1991年 7月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 宮城県黒川郡大和町松坂平1丁目6番地
氏 名 富士フィルムマイクロデバイス株式会社

出願人履歴情報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名 富士写真フィルム株式会社